(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号

特開平10-70315 (43)公開日 平成10年(1998) 3月10日

(51) Int.CI. ^a	徽別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇別
H01L 35/16			HOIL	35/16	
C 2 3 C 14/28			C 2 3 C	14/28	
H 0 1 L 35/34			H01L	35/34	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

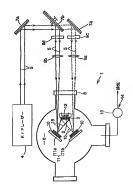
(21)出願番号	特顯平8-223615	(71) 出願人 000000284 大阪瓦斯株式会社
(22) 出願日	平成8年(1996)8月26日	大阪府大阪市中央区平野町四丁目 1 雅 2 号
		(72)発明者 西野 仁
		大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
		(72)発明者 森崎 弘康
		大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
		(72)発明者 山田 良行
		京都府京都市下京区中堂寺南町17 株式会
		社関西新技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 北村 修 (外1名)

(54) 【発明の名称】 熱電材料の製造方法

(57)【要約】

【課題】 有用な熱電特性を有する超格子構造の熱電材 料を、安定して、比較的短時間で製造することができる 熱電材料の製造方法を得る。

【解決手段】 互いに異なった組成を有する複数の材料 層を積層してなり、超格子構造に形成される熱電材料の 製造方法であって、前記複数の材料層に対応した組成を 有する複数のターゲットに対して、レーザー光を順次照 射して、前記複数のターゲットより順次プルームを発生 させて、基板上に蒸着させて、超格子構造を有する熱電 材料を製造する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに異なった組成を有する複数の材料 層を積層してなり、超格子構造に形成される熱電材料の 製造方法であって、前記複数の材料層に対応した組成を 有する複数のターゲットに対して、レーザー光を順次照 射して、前記複数のターゲットより順次プルームを発生 させて、基板上に蒸着させて、超格子構造を有する熱電 材料をレーザーアプレーション法により製造する熱量材 料の製造方法。

1

【請求項2】 前記複数の材料層が、それぞれ 【化1】一般式

(BirSbir) . (Te, Ser,) . $m=2\pm\delta_1$, $n=3\pm\delta_2$

 $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $-1 \le \delta_1 \le 1$, -1, $5 \le$ $\delta_2 \leq 1.5$

で記載可能な組成の熱電材料からなる層である請求項1 記載の熱電材料の製造方法。

【請求項3】 前記各材料層の厚みが10Å~100Å である請求項1または2記載の熱電材料の製造方法。 【請求項4】 互いに異なった組成を有する複数の材料 20 【0003】 層を結層してなる熱電材料の製造方法であって、前記複 数の材料層に対応した組成を有する複数のターゲットに 対して、レーザー光を順次照射して、前配複数のターゲ ットより順次プルームを発生させて、基板上に蒸着させ て、前記各材料層の厚みを10Å~1μmに形成し、熱 電材料をレーザーアプレーション法により製造する熱電 材料の製造方法。

【請求項5】 互いに異なった組成を有する複数の材料 層を積層して熱電材料を製造するにあたって、前記複数 の材料層に対応した組成を有する複数のターゲットに対 30 して、レーザー光を照射して、前記複数のターゲットか らの基板上への蒸着量を経時的に変化させて、前記組成 の異なった材料層を順次形成する、レーザーアプレーシ ョン法による熱電材料の製造方法。

【請求項6】 前記複数の材料層が、それぞれ

【化2】一般式

(B 1 . S b . .) . (T e , S e . .) .

 $m=2\pm\delta_1$, $n=3\pm\delta_2$ $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $-1 \le \delta_1 \le 1$, -1. $5 \le$

 $\delta_2 \leq 1.5$ で記載可能な組成の熱電材料からなる層である譜求項4 または5記載の熱電材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高い熱電特性を有 する材料として、今日提案されている超格子構造を有す る熱電材料、もしくは類似する積層型の熱電材料の製造 方法に関する。

[00002]

【従来の技術】この種の超格子構造を有する熱電材料

は、その有用性が、近来提案されているものであり、例 えば、素子全体として、O.5mm程度の層厚を有する ものが実用的である。このような超格子構造にあって は、各材料層の厚みが10~100Å程度であり、現実 的な意味で熱電素子として、O.5mm厚の素子を得よ うとすると、少なくとも、100000層の積層が必 要となる。超格子構造にあっては、各材料層の層厚が薄 い程、所謂、ZT値が高くなる。従って、できるだけ各 材料層の層厚が薄い構造で、異なった組成の材料層を多 10 層稿層した構造の素子が好ましい。一方、熱電素子とし ては、各材料層の厚みが上記の範囲になくても、1 um 程度以下にある場合は、層内に於ける熱の散逸が起こ り、熟質性能が向上する。このような構造の材料を製造 する製造方法としては、MBB法(分子線エピタキシー 法) 等を使用することが提案されている。この方法にあ っては、組成の異なった複数の出発原料を、所定の温度 に加温された各セル内に収納し、これらのセルの出口に

進める。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな手法では、セル出口に設けられた機械的開閉機構 を、順次開閉操作することが必要となるため、各層間で の切り換えを安定して確実におこなうことが難しい。さ らに、実用的なものを得ようとすると積層量が膨大とな るが、これを比較的短時間でおこなうのは実質上無理で ある。即ち、層内組成、層間組成において安定した所望 の構造を有し、多数の積層状態となっている材料を、比 **較的短時間で得ることが難しいという問題があった。本** 発明の目的は、有用な熱電特性を有する超格子構造の熱 爾材料、もしくは、これに類似する結構型の熱電材料 を、安定して、比較的短時間で製造することができる熱 電材料の製造方法を得ることにある。

設けられる開閉機構を順次開閉しながら、材料の製造を

[0004]

【課題を解決するための手段】 この目的を達成するため の本発明による請求項1に係わり、互いに異なった組成 を有する複数の材料層を箱層してなり、超格子構造に形 成される熱電材料の製造方法の特徴手段は、これら複数 の材料層に対応した組成を有する複数のターゲットに対 40 して、レーザー光を順次照射して、前記複数のターゲッ トより順次プルームを発生させて、基板上に蒸着させ て、超格子構造を有する熱震材料を製造することにあ る。本願にあっては、熱電材料を形成する場合に、所 謂、レーザーアプレーション法が採用される。即ち、所 定の組成のターゲットとこのターゲットに対向して設け られる基板とを、滅圧状態に維持される成膜室内に配設 し、ターゲットにレーザー光を照射して、基板上に膜を 成膜していく。ここで、本願にあっては、異なった組成 を有するターゲットが用意され、これら複数のターゲッ 50 トに順次、レーザー光が照射されて、異なったターゲッ

トの組成に対応した組成の材料層が、基板上に積層状態 で形成される。各材料層の形成にあっては、各ターゲッ トへのレーザー光の照射状態と照射停止状態との切り換 え操作のみで層形成が制御できる(即ち、層厚に関して は所定のターゲットへのレーザー光の照射時間の制御、 材料層の切り換えに関してはレーザー光が照射されるタ ーゲットの選択制御により行える) ため、比較的層厚の 薄いものを多層重合わせることが、容易に実現できる。 即ち、たとえ、本願が一例として対象とするように、1 0~100 Å程度の層厚のものを、少なくとも1000 10 000層近く積層することを、比較的迅速に、安定して おこなうことができる。結果、全体として特性の安定し た所望の材料を得ることができる。

【0005】前記材料層が、それぞれ

[0006]

【化3】一般式

(Bi, Sb₁₂), (Te, Se₁₂),

 $m=2\pm\delta_1$, $n=3\pm\delta_2$

 $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $-1 \le \delta_1 \le 1$, -1, $5 \le$ $\delta_2 \leq 1.5$

【0007】で記載可能な組成の熱電材料からなる層で あることが好ましい。この熱量材料は、材料層の選択及 びその組み合わせにより、比較的低温域で、比較的高い ZT値を得ることができる材料の組み合わせとなるた め、比較的低温の温度域で、従来よりも高い性能を示す 超格子構造の熱電材料を得ることができる。この場合、 対応する層間で組成を異ならせることは、本廟の目的か ら当然である。

【0008】 ここで、熱電材料として、好ましい形態と しては、前記各材料層の厚みが10~100Åであり、 少なくとも1万層以上が結層されていることが好まし い。超格子構造を採用する場合にあって、熱電材料がそ の特性として良好な値を示す各材料層単独の層厚みは、 10~100 Å 程度であり、これを 1 万層以上、 積層す ることにより、有用な熱質材料を得ることができる。本 願にあっては、レーザーアブレーション方式を採用する ため、こういった機造のものにあっても、比較的容易 に、迅速に製造が行えるのは、先に述べたとおりであ

【0009】さらに、熱電材料を製造する場合に、上記 40 のような各層厚が、10~100Åの範囲になく、1 μ m程度以下の層厚を有する各材料層を積層した場合にあ っても、この層内で熱の散逸が発生する。従って、熱電 材料として考えた場合、層厚を10Å~1μmの範囲内 に選択すると、その特性を向上させる要素となる熱伝導 率の低下を図ることができる。従って、各層厚が上記程 度の層を多数積層して、熱電材料を製造することが好ま しい。この場合、熱電材料の製造にあたっては、上記と 同様に、前記複数の材料層に対応した組成を有する複数 のターゲットに対して、レーザー光を順次照射して、前 50 成膜室6に設けられる石英入射窓8の手前に、レーザー

記複数のターゲットより順次プルームを発生させて、基 板上に蒸着させて作製するのが好ましく、各材料層の厚 みを10Å~1 umに形成することが好ましい。この場 合、各層の組成の一例を示すとBi,Te,層と、Sh, Tes層とを交互に所定の層厚で積層していくことがで

【0010】また、熱電材料は、その使用状態にあって 厚み方法に温度傾斜が存在する。従って、この温度傾斜 に対応した、異なった組成を有する複数の材料層を積層 してなり、しかも、この層内自体、さらには、同種の相 にあっても、熱電材料の厚み方向で位置が異なった同一 種材料層間で、その組成が傾斜的に変化した熱電材料を 得たい場合もある。このような場合にあって、互いに暴 なった組成を有する複数の材料層を積層して熱電材料を 製造するにあたって、前記複数の材料層に対応した組成 を有する複数のターゲットに対して、同時にレーザー光 を照射して、前記複数のターゲットからの基板上への蒸 着量(堆積量)を経時的に変化させて、前記組成の異な った材料層を順次形成する、レーザーアプレーション法 20 を採用すると、材料の厚み方向で、組成が所望状態で変 化する材料を容易に得ることができる。上記したそれぞ れの場合にあってもまた、前記材料層が、それぞれ [0011]

【化4】一般式

(BixSb₁₋₂) . (TeySe_{1-y}) .

 $m=2\pm\delta_1$, $n=3\pm\delta_2$

 $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $-1 \le \delta_1 \le 1$, -1. $5 \le$ $\delta_2 \leq 1.5$

【0012】で記載可能な組成の熱電材料からなる層で 30 あることが好ましい。

[0013]

【発明の実施の形態】本願の実施の形態を以下に説明す る。説明にあたっては、本願で使用されるレーザーアブ レーション装置1の構成 - 紹格子機造の熱電材料を製造 する場合のレーザーアブレーション条件について説明す る。

[0014] 1 レーザーアブレーション装置1 図1に、レーザーアブレーション装置1を使用して、シ リコン基板3上に本願の超格子構造を有する熱電材料2 を作製している状況を示している。装置1は、エキシマ レーザー4を備えるとともに、このレーザー4から照射 されるレーザー光5により、成際をおこなう成膜室6を 備えて構成されている。レーザーアブレーション装置に は、このレーザー4から照射されるレーザー光5を前記 成膜室6内に導くための全反射型のミラー7 aと、レー ザー光を透過する状態と全反射する状態とに適宜切り換 える切り換えミラー7bとが所定の箇所に備えられてい る。切り換えミラー 7 h の正面図を図3 に示した。斜線 部が全反射部であり、空白部が透過部である。さらに、

5 光成形用の成形用レンズ系9 a、9 bが備えられ、この 成形用レンズ系の手前に、ターゲット10に照射される レーザー光5のエネルギー密度を必要に応じて調節する 減衰装置9 c、9 dが備えられている。前記成勝室6 に は、ターゲット10を保持するための一対のターゲット 保持台11と、これらの保持台11に対向して設けら れ、且つ前記基板3を所定の成膜基板温度に維持可能な 基板保持台12を備えている。成膜室6は、室内を所定 の真空度に保持するために、真空ポンプ13を備えた排 気機構14を備えている。熱電材料2の作製にあたって 10 層が交互に現れる組成構造を示し、熱電特性を示した。 は、前記一対のターゲット保持台11夫々に別種のター ゲット10を保持するとともに、基板保持台12に基板 3を保持して材料の作製をおこなう。この場合に、前記 切り換えミラー7 bをその軸芯回りに回転操作してレー ザー光5が、夫々のターゲット10に交互に照射されて (当てられて)、レーザーアプレーションをおこなうこ とができる。

【0015】従って、熱電材料2の作製にあたっては、 原材料である各種元素を所定の組成比で含有する一封の ターゲット10(各ターゲット間においては、それらの 20 組成比は異なっている)が作製されるとともに、滅圧真 空維持される前記成膜室6内で、夫々のターゲット10 を成膜対象の基板3対向して配設し、これらのターゲッ ト10にレーザー光5が、順次、切り換えミラー7 bの 回転に伴って、切り換え状態で照射されて、ターゲット 10よりプルーム15が発生されて、基板3上に順次蒸 着され、熱電材料が作製される。以上が、本願の方法を 採用する場合の装置構成及び熱電材料の概略的な作製状 祝である。

【0016】1 先ず図2に示す材料16の作製につい 30 て説明する。この材料16は、所謂、BI-Te系材料 であり、その組成がBlzTezの材料層と、ShzTez の材料層とを交互に備えたのものである。同図において 17は高温側電極を、18は低温側電極を示している。 図1に示す例においては、上部側に位置されるターゲッ ト保持台11aにBizTezを主成分とする材料から構 成されるターゲット10が、下部側に位置されるターゲ ット保持材11bにSb2Te3を主成分とする材料から 構成されるターゲット 10 が配設される。以下、具体的 な作製条件を下記の表1に簡条書きする。

[0017]

【表1】	
作製対象物	超格子構造を有する熱電材料
基板材料	S I (100) P型
作製基板温度	275℃
成膜室真空度	10 ⁻⁶ Torr
レーザー波長	2 4 8 n m
レーザーパワー密度	6000mJ/cm ²
レーザーパルス繰り	返し数 10Hz
作製対象膜厚	0. 5 μm

【0018】そして、一対のターゲット10に対して、 交互にレーザー光5を照射することにより、基板3上に 所定の組成の材料層を積層することができる。ここで、 各材料層に対応する照射時間は、以下のとおりである。 Bi₂Te₂ 照射時間 10秒 SbzTes 照射時間 10秒

ここで、各層のアプレーション操作時間内において、成 膜対象面全面に所望の材料層が形成されることは当然で ある。このようにして作製された材料は、各組成の材料

【0019】 (さらなる実施の形態) 上紀の実施の形態 例においては、テルル化ピスマスが主成分であるBi-Te系の熱電材料を作製する例を示したが、Bi-Te系の他、B1-Sb系、B1-Se系等、ビスマス、テ ルル、アンチモン、セレンから選択される少なくとも2 種以上を含む熱電材料の作製にあっては、本願の手法を 適広できる。即ち、

[0020] [化5] 一般式

(BirSbir) (TerSeir) a

 $m=2\pm\delta_1$, $n=3\pm\delta_2$ $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $-1 \le \delta_1 \le 1$, -1. $5 \le$ $\delta_2 \leq 1.5$

【0021】から選択される、別の組成を有する材料 が、超格子構造を有する精層した材料層を構成するの に、好ましい。 【0022】上記の実施の形態においては、エキシマレ

ーザーを採用したが、ネオジム (Nd^{*}) YAGレーザ 一等を使用してもよい。さらに、基板としては、シリコ ン基板の他、ガラス等、平滑な任意の材料を使用でき る。ガラスの場合は、製品が安価となる利点がある。さ らに、上記の実施例においては、ターゲットとして、一 対のターゲットを使用する例を示したが、本願において は、複数であれば、本節の作用・効果を奉することがで きる。

【0023】上記の実施の形態においては、材料の厚み 方向に、複数の材料層を形成する場合を示したが、レー ザーアプレーション時にマスク操作をしながら、所定の 材料層が形成される部位を基板上で変更することによ り、2次元、3次元の超格子も製造することができる。 さらに、複数のターゲットからの成膜を共におこないな がらも、複数のターゲット間で、各ターゲットに照射さ れるレーザー光の強度を相対的に変更することでも、各 ターゲットから蒸着される量を変更して、材料層の組成

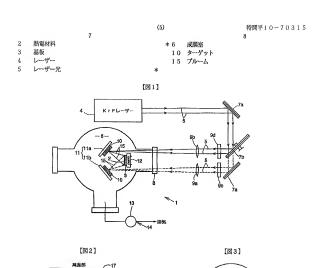
【図面の簡単な説明】 【図1】レーザーアブレーション装置の構成を示す図

【図2】熱館材料の構成を示す図

【図3】切り換えミラーを軸方向から見た図

を厚み方向に変化させることも可能である。

50 【符号の説明】



CZZI Sb₂Te₃